ヌ～ワ　（略）

カ　ドライエッチング用に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの

（一）　（略）

（二）　異方性ドライエッチング用に設計し、又は改造した装置であって、次の全てに該当するもの（ア（一）又はサに該当するものを除く。）

１　（略）

２　切替時間が五〇〇ミリ秒未満の高速ガス切替弁を一以上有するもの

３　静電チャック（個別に温度を制御することができる領域を一〇以上有するものに限る。）を有するもの

ヨ　（略）

タ　異方性エッチング用に設計した装置であって、誘電体の材料に対して、エッチングの幅に対する深さの比率が三〇倍を超え、かつ、当該幅の寸法が一〇〇ナノメートル未満の形状を形成することができるもののうち、次の全てに該当するもの（カ（二）、ヨ、ア（一）又はサに該当するものを除く。）

（一）　高周波のパルス出力の電源を一以上有するもの

（二）　切替時間が三〇〇ミリ秒未満の高速ガス切替弁を一以上有するもの

レ　半導体製造装置のうち、成膜装置であって、次のいずれかに該当するもの

（一）・（二）　（略）

（三）　単一のチャンバー内での複数の工程によって金属のコンタクト層を成膜するように設計した装置であって、次の全てに該当するもの（（二）に該当するものを除く。）

１　（略）

２　水素、水素と窒素の混合物又はアンモニアを用いたプラズマにより表面処理を行う工程を有するもの

（四）　半導体製造装置であって、複数のチャンバー又はステーション内での複数の工程によって成膜するように設計したもの（以下「特定半導体製造装置」という。）のうち、次に掲げる全ての工程により金属のコンタクト層を成膜するように設計したもの（（二）に該当するものを除く。）

１～３　（略）

（五）～（十）　（略）

ソ　特定半導体製造装置のうち、金属の層を成膜するように設計した装置であって、次の全てに該当するもの（レ（二）に該当するものを除く。）

（一）・（二）　（略）

ツ　特定半導体製造装置のうち、金属の層を成膜するように設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの（レ（二）に該当するものを除く。）

（一）・（二）　（略）

ネ・ナ　（略）

ラ　成膜装置であって、次のいずれかに該当するもの（キ（三）に該当するものを除く。）

（一）・（二）　（略）

ム　（略）

ヌ～ワ　（略）

カ　ドライエッチング用に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの

（一）　（略）

（二）　異方性ドライエッチング用に設計し、又は改造した装置であって、次の全てに該当するもの

１　（略）

２　切替時間が三〇〇ミリ秒未満の高速ガス切替弁を一以上有するもの

３　静電チャック（個別に温度を制御することができる領域を二〇以上有するものに限る。）を有するもの

ヨ　（略）

タ　異方性エッチング用に設計した装置であって、誘電体の材料に対して、エッチングの幅に対する深さの比率が三〇倍を超え、かつ、当該幅の寸法が一〇〇ナノメートル未満の形状を形成することができるもののうち、次の全てに該当するもの（カ又はヨに該当するものを除く。）

（一）　高周波のパルス出力の電源を一以上有するもの

（二）　切替時間が三〇〇ミリ秒未満の高速ガス切替弁を一以上有するもの

レ　半導体製造装置のうち、成膜装置であって、次のいずれかに該当するもの

（一）・（二）　（略）

（三）　単一のチャンバー内での複数の工程によって金属のコンタクト層を成膜するように設計した装置であって、次の全てに該当するもの（（二）に該当するものを除く。）

１　（略）

２　水素（水素と窒素又はアンモニアとの混合物を含む。）を用いたプラズマによる工程を有するもの

（四）　半導体製造装置であって、複数のチャンバー又はステーション内での複数の工程によって成膜するものであり、かつ、複数の工程間において〇・〇一パスカル以下の真空状態又は不活性の環境を維持することができるように設計したもの（以下「特定半導体製造装置」という。）のうち、次に掲げる全ての工程により金属のコンタクト層を成膜するように設計したもの（（二）に該当するものを除く。）

１～３　（略）

（五）～（十）　（略）

ソ　〇・〇一パスカル以下の真空状態又は不活性ガスの環境において金属の層を成膜するように設計した装置であって、次の全てに該当するもの（レ（二）に該当するものを除く。）

（一）・（二）　（略）

ツ　〇・〇一パスカル以下の真空状態又は不活性ガスの環境において金属の層を成膜するように設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの（レ（二）に該当するものを除く。）

（一）・（二）　（略）

ネ・ナ　（略）

ラ　成膜装置であって、次のいずれかに該当するもの

（一）・（二）　（略）

ム　（略）